

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0219U001766

Державний реєстраційний номер: 0117U000538

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-02-2019

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Розробка методів, технологій керування за допомогою іонів, швидких електронів, нейтронів параметрами дискретних транзисторів та інтегральних мікросхем спеціального призначення.

Початок етапу: 01.2018

Закінчення етапу: 12.2018

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний політехнічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071045

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (048)7058489

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 309.9
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Методи і технології радіаційного керування параметрами та стійкістю активних елементів електроніки до дії іонізуючих випромінювань.

Назва роботи англійською:

Methods and technologies of radiation control of the parameters and resistance of active elements of electronics to the action of ionizing radiation.

Реферат українською:

Метою роботи є вивчення закономірностей зміни електричних характеристик виробів мікроелектроніки під дією опромінення швидкими електронами і швидкими нейтронами, розробка технології їх радіаційної обробки. В результаті проведених досліджень визначені порогові дози радіаційного впливу швидкими електронами і швидкими нейтронами для перелічених виробів. Показана можливість радіаційного управління температурним коефіцієнтом напруги напівпровідникових датчиків температури і одним з параметрів гібридних мікросхем. Розроблена технологія радіаційної обробки може бути використана виробниками мікросхем для вдосконалення технологічного процесу їх виробництва, а також для розробки доповнень до технічних умов на ці вироби.

Реферат англійською:

An aim of work is a study of conformities to law of change of electric descriptions of wares of microelectronics under the action of irradiation rapid electrons and rapid neutrons, development of technology of their radiation treatment. As a result of undertaken studies the threshold doses of radiation influence are certain by rapid electrons and rapid neutrons for the enumerated wares. Possibility of radiation management is shown by the temperature coefficient of tension of semiconductor sensors of temperature and one of parameters of hybrid microcircuits. The worked out technology of radiation treatment can be used by the producers of microcircuits for the improvement of technological process of their production, and also for development of adding to the technical requirements on these

Індекс УДК: 539.1.08, 539.1.06 : 539.16.04 : 621.039.84

Коди тематичних рубрик: 29.15.39

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мокріцький Вадим Анатолійович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Методи та технології радіаційного керування електрофізичними властивостями об'ємних монокристалів та шарів напівпровідників та стійкістю приладів на їх основі.

Назва НТП англійською: Radiation control methods and technologies electrophysical properties of monocrystals, layers and devices on this basis.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: Приладобудування. Мікроелектроніка. Ядерна енергетика

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: В результаті проведених досліджень визначені порогові дози радіаційного впливу швидкими електронами і швидкими нейтронами для перелічених виробів. Показана можливість радіаційного управління температурним коефіцієнтом напруги напівпровідникових датчиків температури і одним з параметрів гібридних мікросхем. Розроблена технологія радіаційної обробки може бути використана виробниками мікросхем для вдосконалення технологічного процесу їх виробництва

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2019

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Підприємства приладобудування, мікроелектроніки

Перспективні ринки: Україна, Європа

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Дмитришин Дмитро Володимирович

Перелік осіб-виконавців

Анісімов В.О.

Банзак О.В.

Бондар Г.І.

Галчюнков О.М.

Казаков А.І.

Кальнев Л.Л.

Маслов О.В.

Миронов В.С.

Свірідова С.В.

Соколов А.В.

Улізко Г.В.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

